

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 10 月 25 日 (2007.10.25)

【公開番号】特開 2001-142224 (P2001-142224A)

【公開日】平成 13 年 5 月 25 日 (2001.5.25)

【出願番号】特願 2000-258450 (P2000-258450)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

G 0 9 F 9/00 (2006.01)

H 0 1 L 27/08 (2006.01)

G 0 2 F 1/1368 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

H 0 1 L 21/8238 (2006.01)

H 0 1 L 27/092 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/20 5 0 1

G 0 9 F 9/00 3 4 2 Z

H 0 1 L 27/08 3 3 1 E

G 0 2 F 1/1368

H 0 1 L 21/30 5 1 4 A

H 0 1 L 27/08 3 2 1 F

H 0 1 L 27/08 3 2 1 N

H 0 1 L 29/78 6 1 2 D

H 0 1 L 29/78 6 1 2 B

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 8 月 27 日 (2007.8.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被加工物を基板上に形成し、

前記被加工物上にレジストを塗布し、

前記レジストに第 1 の露光手段によって第 1 のパターンを形成し、

前記第 1 のパターンの一部に、前記第 1 の露光手段と異なる第 2 の露光手段によって第 2 のパターンを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 2】

被加工物を基板上に形成し、

前記被加工物上にレジストを塗布し、

前記レジストの第 1 の領域と第 2 の領域を第 1 の露光手段によって露光して、前記第 1 の領域と前記第 2 の領域との間に第 1 のパターンを形成し、

前記第 1 のパターンの一部である第 3 の領域と第 4 の領域を、前記第 1 の露光手段と異なる第 2 の露光手段によって露光して、前記第 3 の領域と前記第 4 の領域との間に第 2 のパターンを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 3】

被加工物を基板上に形成し、
前記被加工物上にレジストを塗布し、
前記レジストに第 1 の露光手段によって第 1 のパターンを形成し、
前記第 1 のパターンの一部に、前記第 1 の露光手段と異なる第 2 の露光手段によって第 2 のパターンを形成し、
前記第 1 の露光手段における解像度と前記第 2 の露光手段における解像度が異なることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 4】

被加工物を基板上に形成し、
前記被加工物上にレジストを塗布し、
前記レジストの第 1 の領域と第 2 の領域を第 1 の露光手段によって露光して、前記第 1 の領域と前記第 2 の領域との間に第 1 のパターンを形成し、
前記第 1 のパターンの一部である第 3 の領域と第 4 の領域を、前記第 1 の露光手段と異なる第 2 の露光手段によって露光して、前記第 3 の領域と前記第 4 の領域との間に第 2 のパターンを形成し、
前記第 1 の露光手段における解像度と前記第 2 の露光手段における解像度が異なることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 5】

請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか一において、
前記第 1 の露光手段における露光範囲と前記第 2 の露光手段における露光範囲が異なることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか一において、
前記第 1 の露光手段における露光装置と前記第 2 の露光手段における露光装置が異なることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか一において、
前記第 1 の露光手段においてミラープロジェクションを用い、前記第 2 の露光手段においてステッパを用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 8】

請求項 1 乃至請求項 7 のいずれか一において、
前記第 1 のパターンの最小線幅と前記第 2 のパターンの最小線幅が異なることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 9】

請求項 1 乃至請求項 8 のいずれか一において、
前記被加工物に、半導体膜、導電膜又は絶縁膜を用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 10】

請求項 1 乃至請求項 9 のいずれか一において、
前記基板に、石英基板、ガラス基板、プラスチック基板又は半導体基板を用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。